

Title (en)

Device for charging a dielectric layer electrostatically.

Title (de)

Vorrichtung zum elektrostatischen Aufladen einer dielektrischen Schicht.

Title (fr)

Dispositif pour le chargement électrostatique d'une couche diélectrique.

Publication

EP 0011203 A1 19800528 (DE)

Application

EP 79104302 A 19791105

Priority

DE 2849222 A 19781113

Abstract (en)

[origin: US4353970A] A method and an apparatus for charging a dielectric layer electrostatically to a predetermined potential. An AC electrode is arranged at a distance from the dielectric layer and connected to one output of an AC voltage generator. The AC voltage generator has the other output connected to an output of a DC voltage generator. Between the AC electrode and the dielectric layer there is a DC electrode which is connected to the other output of the AC voltage generator. The dielectric layer rests on a counter-electrode which is connected to the other output of the DC voltage generator and is at ground potential. Each of the electrodes can comprise one or a plurality of mutually insulated single electrodes.

Abstract (de)

Verfahren zum elektrostatischen Aufladen einer dielektrischen Schicht sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens. Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum elektrostatischen Aufladen einer dielektrischen Schicht auf ein vorgegebenes Potential. Hierzu ist eine Elektrode (7) im Abstand von der dielektrischen Schicht (8) angeordnet und an den einen Ausgang (21) eines Wechselspannungsgenerators (2) angeschlossen, dessen anderer Ausgang (20) mit dem spannungsführenden Ausgang (11) eines Gleichspannungsgenerators (1) verbunden ist. Zwischen der Elektrode (7) und der Schicht (8) ist eine weitere Elektrode (5) vorhanden, die an den Ausgang (11) des Gleichspannungsgenerators (1) angeschlossen ist. Die Schicht (8) liegt auf einer Gegenelektrode (9) zu der Elektrode (5) auf und ist auf Masse gelegt. Jede der Elektroden (5,7,9) kann aus mehreren, voneinander isolierten Einzelelektroden bestehen.

IPC 1-7

G03G 13/02; **G03G 16/00**

IPC 8 full level

G03G 15/02 (2006.01); **G03G 16/00** (2006.01); **H01T 19/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)

G03G 15/0291 (2013.01 - EP US); **G03G 16/00** (2013.01 - EP US); **Y10S 430/102** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- DE 2511633 A1 19760923 - HOECHST AG
- DE 2352656 A1 19750507 - GORDON LYSLE INC
- DE 2611503 A1 19761118 - XEROX CORP
- FR 1041698 A 19531026 - BATTTELLE DEVELOPMENT CORP
- DE 1572381 A1 19700226 - WABASH MAGNETICS INC
- GB 1374923 A 19741120 - XEROX CORP
- GB 1480321 A 19770720 - XEROX CORP
- US 4096543 A 19780620 - KOZUKA NOBUHIKO, et al
- US 4086650 A 19780425 - DAVIS THOMAS G, et al
- US 3708661 A 19730102 - HANSEN N, et al

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB IT NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0011203 A1 19800528; **EP 0011203 B1 19831123**; AT E5443 T1 19831215; AU 5266379 A 19800522; AU 530752 B2 19830728; CA 1139360 A 19830111; DE 2849222 A1 19800522; DE 2966426 D1 19831229; JP S5569152 A 19800524; US 4353970 A 19821012; US 4415947 A 19831115

DOCDB simple family (application)

EP 79104302 A 19791105; AT 79104302 T 19791105; AU 5266379 A 19791109; CA 338791 A 19791030; DE 2849222 A 19781113; DE 2966426 T 19791105; JP 14610679 A 19791113; US 25498181 A 19810416; US 9227679 A 19791108